

2016年12月期 第2四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社
2016年11月2日

2016年12月期 第2四半期決算概要

経営者が意思決定する際に使用する指標（以下Non-GAAPベース）を資料上開示しております。

Non-GAAP連結業績は、財務会計上の数値（GAAP）から非経常項目やその他の調整項目を控除したもので、当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しております。

当社は、平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会で、定款一部変更の件を決議し、平成28年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる平成28年12月期につきましては、平成28年4月1日から平成28年12月31日の9ヶ月間となります。当社は、通期の業績予想に代えて、翌四半期累計期間の業績予想を開示しております。

2016年12月期 第2四半期 決算概要

売上高、半導体売上高の前年同期比、前四半期比、予想比は小数点以下第2位を四捨五入

(億円)	2016年3月期	2016年12月期						
	第2四半期	第1四半期	第2四半期 予想	第2四半期	前年同期比	前四半期比	予想比	上期
売上高	1,814	1,520	1,490	1,526	△15.9%	+0.4%	+2.4%	3,046
半導体売上高	1,770	1,475	1,450	1,483	△16.2%	+0.5%	+2.3%	2,958
売上総利益率	47.1%	42.8%	38.9%	41.2%	△5.9Pts.	△1.6Pts.	+2.4Pts.	42.0%
営業利益(率)	307 (16.9%)	186 (12.2%)	74 (5.0%)	146 (9.5%)	△162 (△7.4Pts.)	△40 (△2.7Pts.)	+71 (+4.5Pts.)	331 (10.9%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	275	100	15	94	△181	△6	+79	194
EBITDA ^{*1}	463	331	219	295	△168	△36	+75	626
1 米ドル	123円	111円	103円	104円	19円円高	7円円高	1円円安	107円
1 ユーロ	137円	124円	116円	116円	21円円高	8円円高	-	120円

*1 EBITDA：営業利益+減価償却費+長期前払費用償却額

2016年12月期 第2四半期 業績サマリー (Non-GAAPベース*1)

実績

半導体売上高 1,483億円

前四半期比 : +0.5%

予想比 : +2.3%

売上総利益率 42.5%

前四半期比 : △1.8 Pts.

前年同期比 : △3.3 Pts.

営業利益率 10.8%

前四半期比 : △2.9 Pts.

前年同期比 : △4.8 Pts.

主な要因

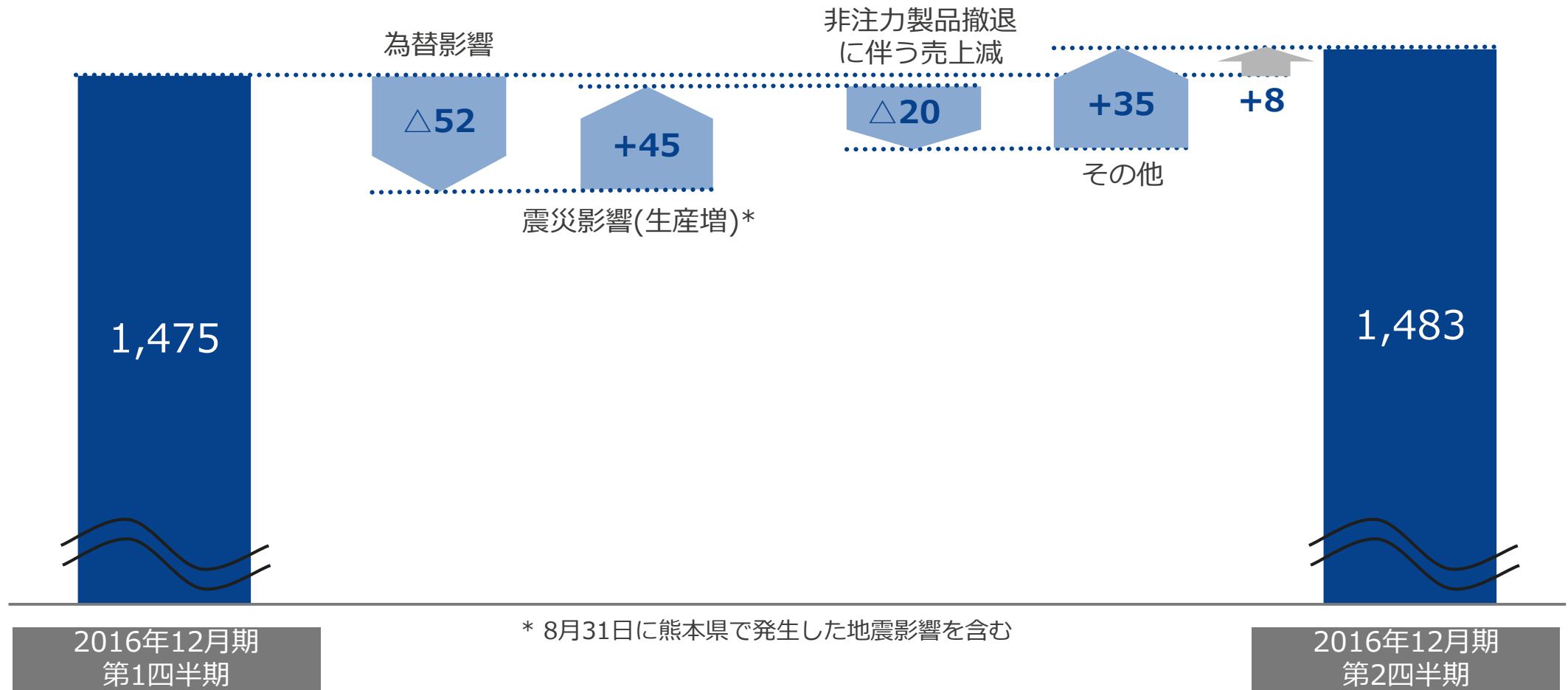
- 円高および非注力製品からの撤退影響があるものの、自動車向けを中心に堅調な需要の下、震災影響が軽減し、前四半期比微増
- 8月末の熊本地震の影響が一部出たものの、全体では計画以上の生産挽回により、予想比増
- 夏の電力需要増など季節要因による費用増により、前四半期比減
- 構造改革効果は着実に出ているが、円高および震災影響による売上減があり、前年同期比減
- 売上総利益減少に加え、季節要因によるR&D*2やSG&A*3の増加により、前四半期比減
- 前年同期比では減少となるも、構造改革効果により二桁の利益率は確保

*1 Non-GAAPベース : RSP(ルネサスエスピードライバ)にかかる売上および損益の影響、LTEモデム事業にかかる損益の影響、作り貯めの損益の影響を控除

*2 R&D : 研究開発費 *3 SG&A : 販売費および一般管理費

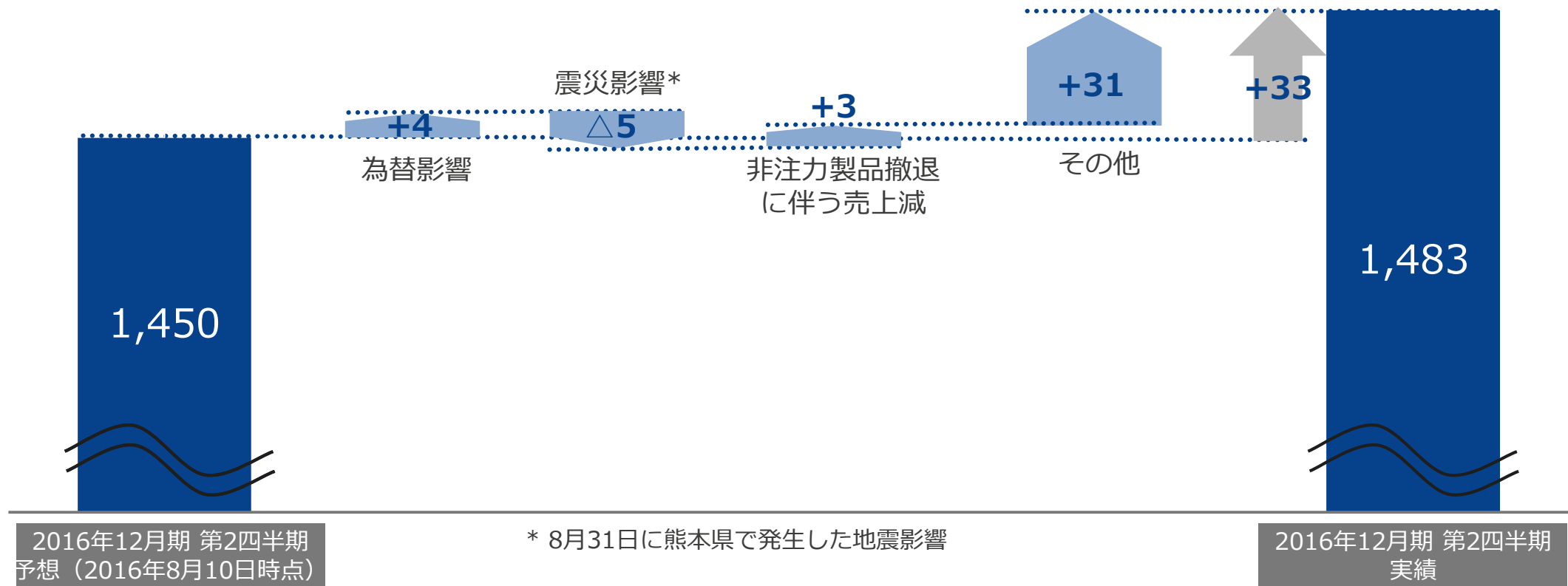
2016年12月期 第2四半期 半導体売上高(Non-GAAPベース)

前四半期比 (億円)



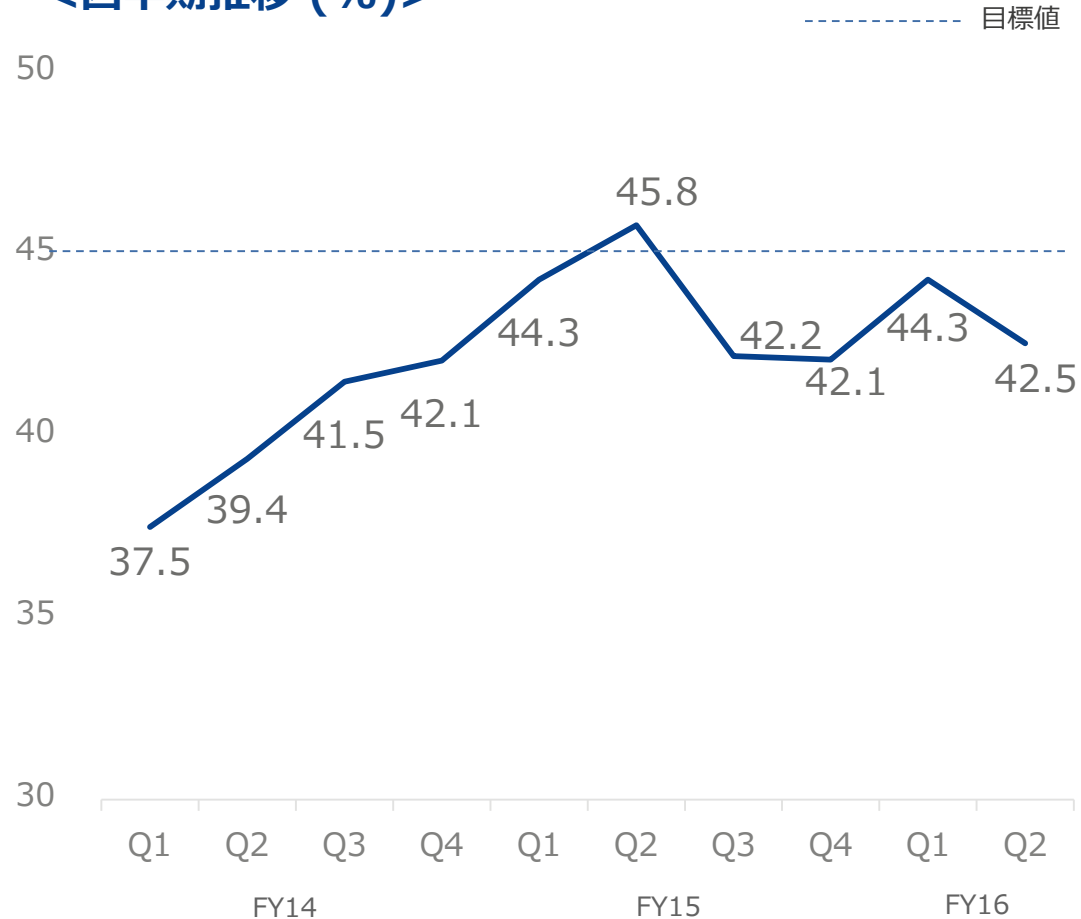
2016年12月期 第2四半期 半導体売上高(Non-GAAPベース)

予想比 (億円)

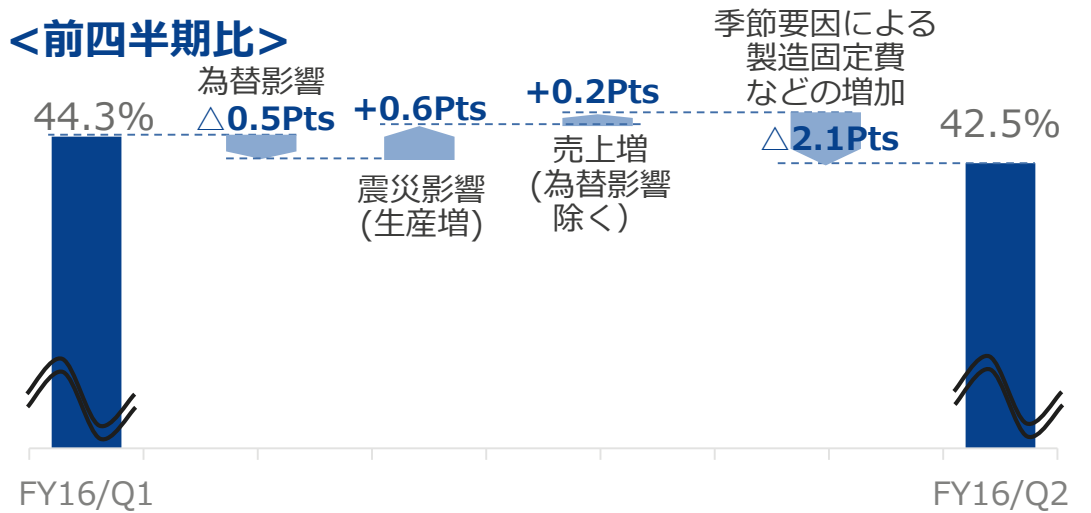


売上総利益率 (Non-GAAPベース)

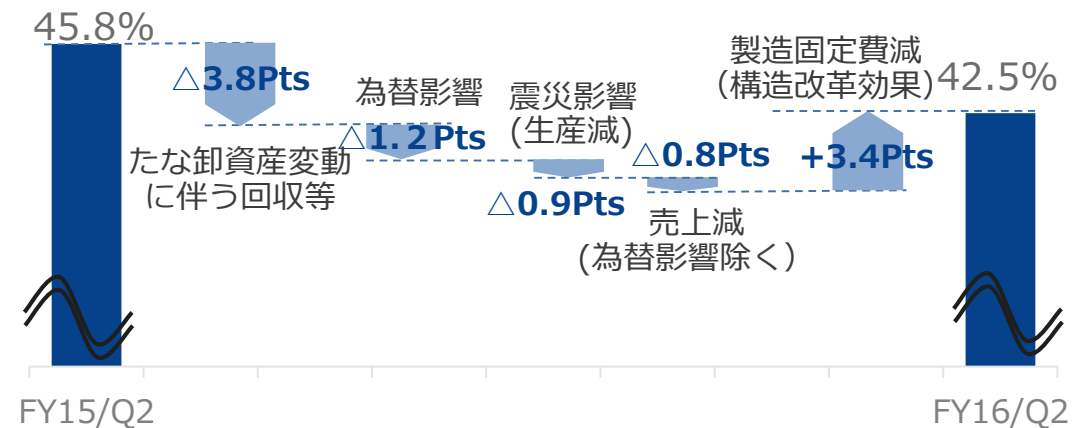
<四半期推移 (%)>



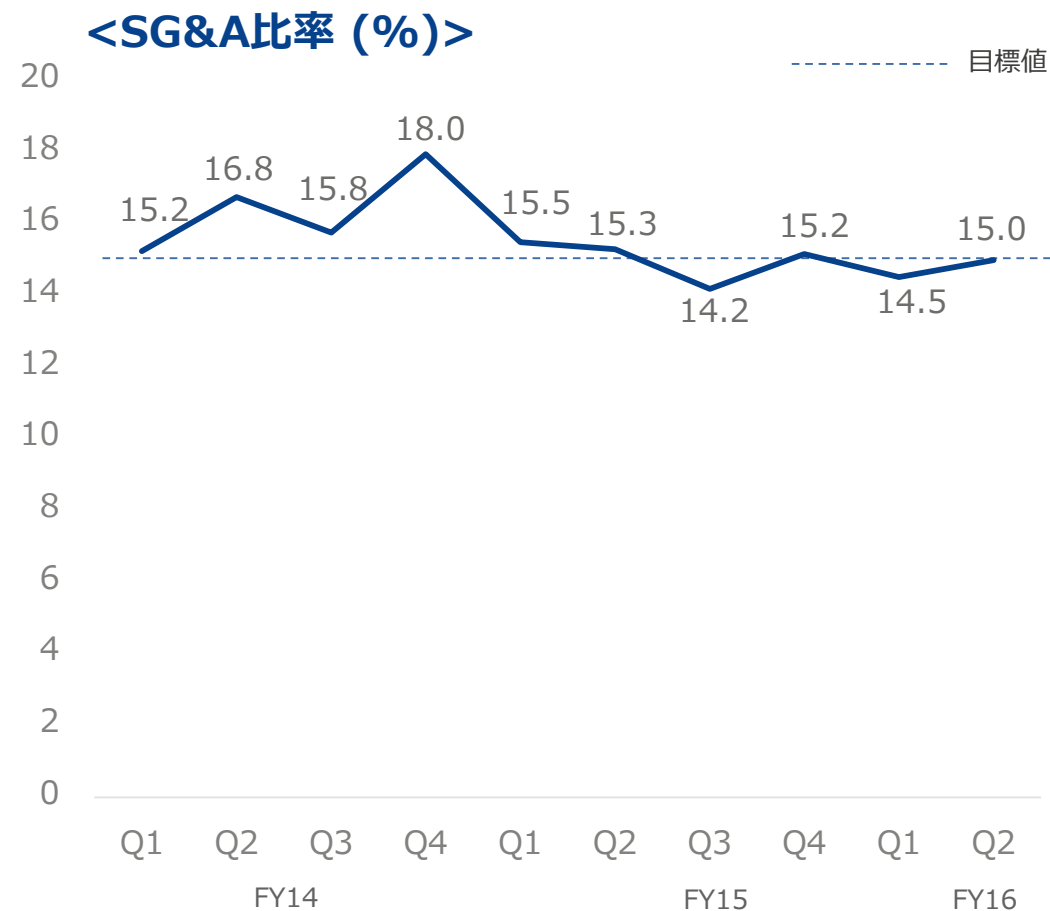
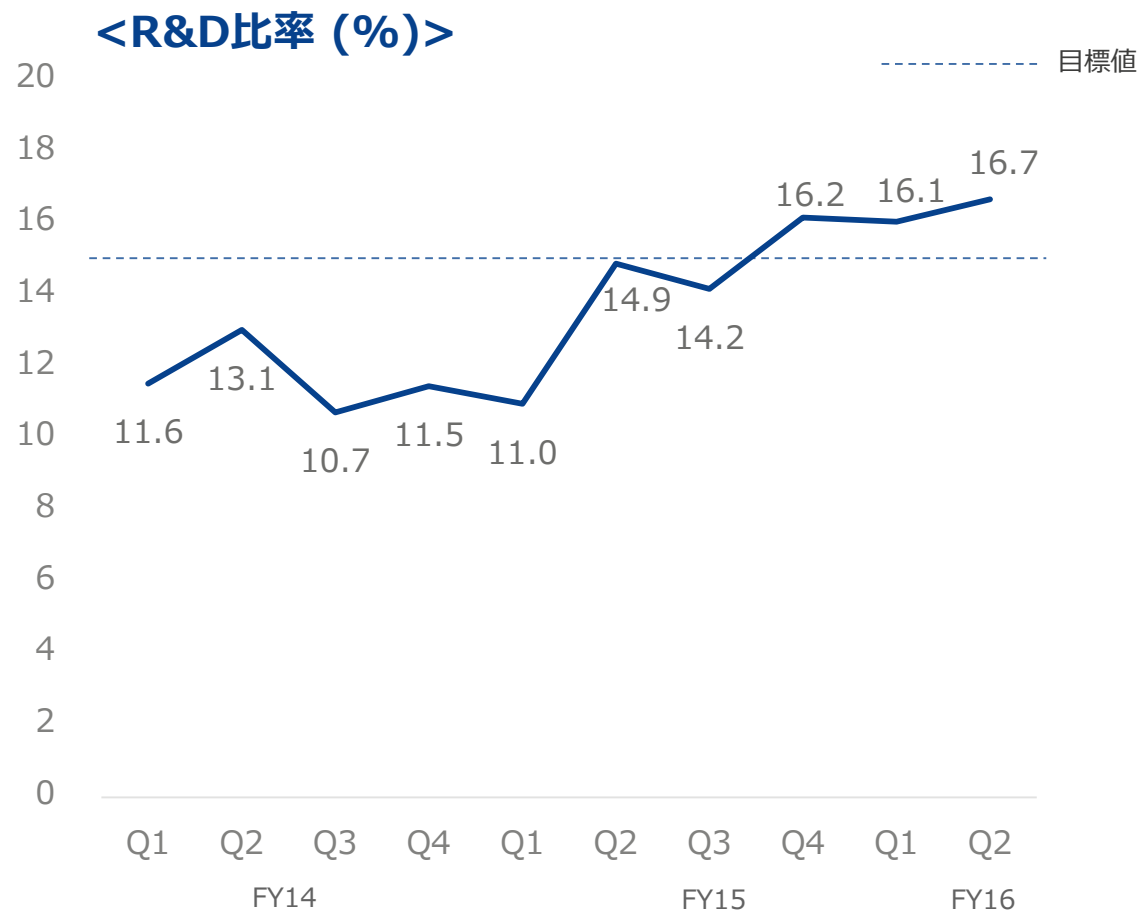
<前四半期比>



<前年同期比>



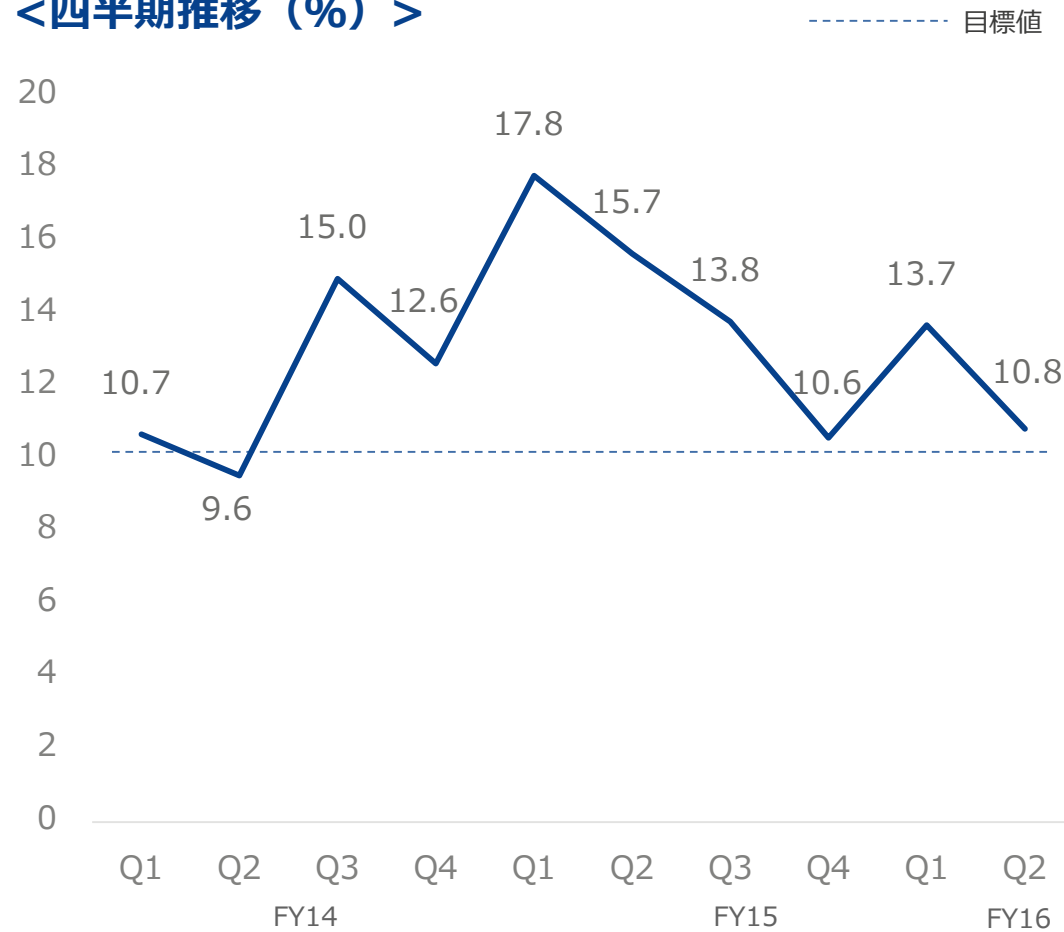
OPEX*1 (Non-GAAPベース)



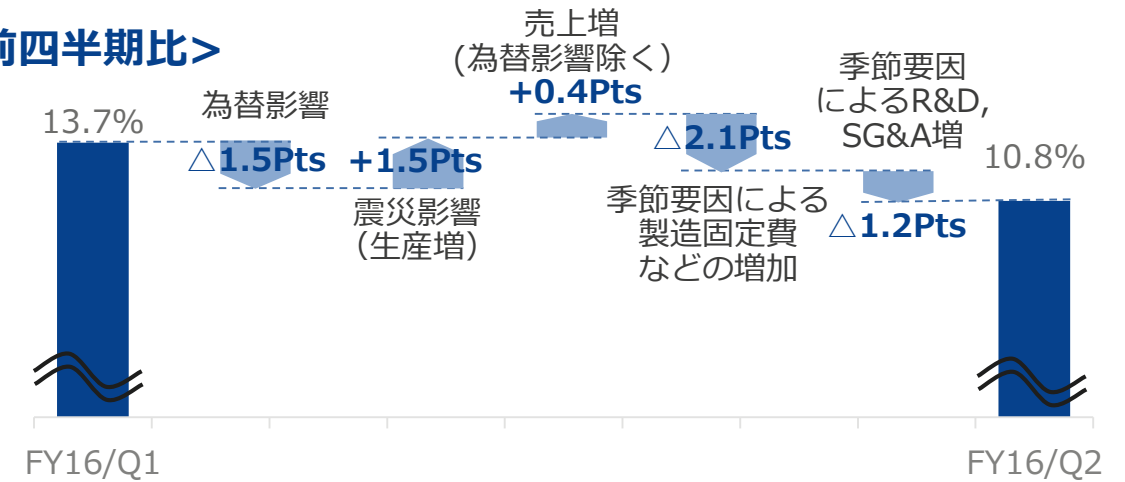
*1 OPEX : Operating Expenseの略でR&D、SG&Aなどの事業運営に必要な費用のこと

営業利益率 (Non-GAAPベース)

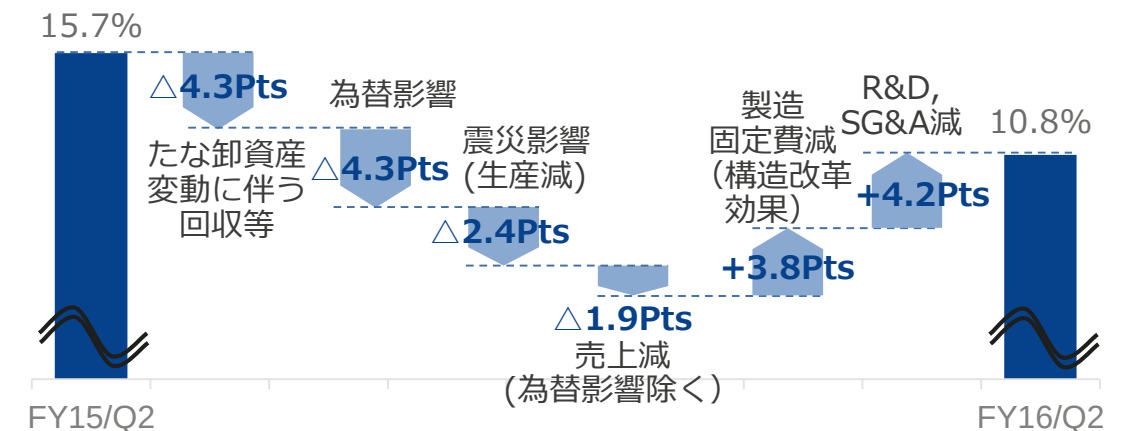
<四半期推移 (%)>



<前四半期比>



<前年同期比>



2016年12月期 第3四半期および 通期業績予想

2016年12月期 第3四半期 業績予想サマリー

予想

半導体売上高 1,572億円
前四半期比：+6.0%

売上総利益率 42.8%
前四半期比：+1.5 Pts.

営業利益率 12.9%
前四半期比：+3.4 Pts.

主要要因

- 震災影響の軽減および堅調な需要を背景とする生産増により、前四半期増を見込む
- 売上増に伴う利益増により、前四半期比増を見込む
- 前四半期とほぼ同額のR&DおよびSG&Aを計画するが、売上総利益の増加により、前四半期比増を見込む

2016年12月期 通期（2016年4月～12月） 業績予想サマリー

予想

半導体売上高 4,530億円
前年同期比：△11.6%

売上総利益率 42.3%
前年同期比：△2.8 Pts

営業利益率 11.6%
前年同期比：△5.2 Pts

主な要因

- 円高、非注力製品の撤退および震災影響により、前年同期比減を見込む
- 売上減に伴い、売上総利益・売上総利益率は減少を見込むものの構造改革による改善効果もあり、減少幅は改善する見込み
- 成長のためのR&D増により、前年同期比減を見込むが、構造改革による改善効果により、営業利益率二桁は確保する見込み

注）当社は、2016年度より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2016年12月期については、2016年4月1日から2016年12月31日の9ヶ月間となります。前年同期比は、2016年3月期第3四半期連結累計期間（2015年4月1日～12月31日）との比較です。

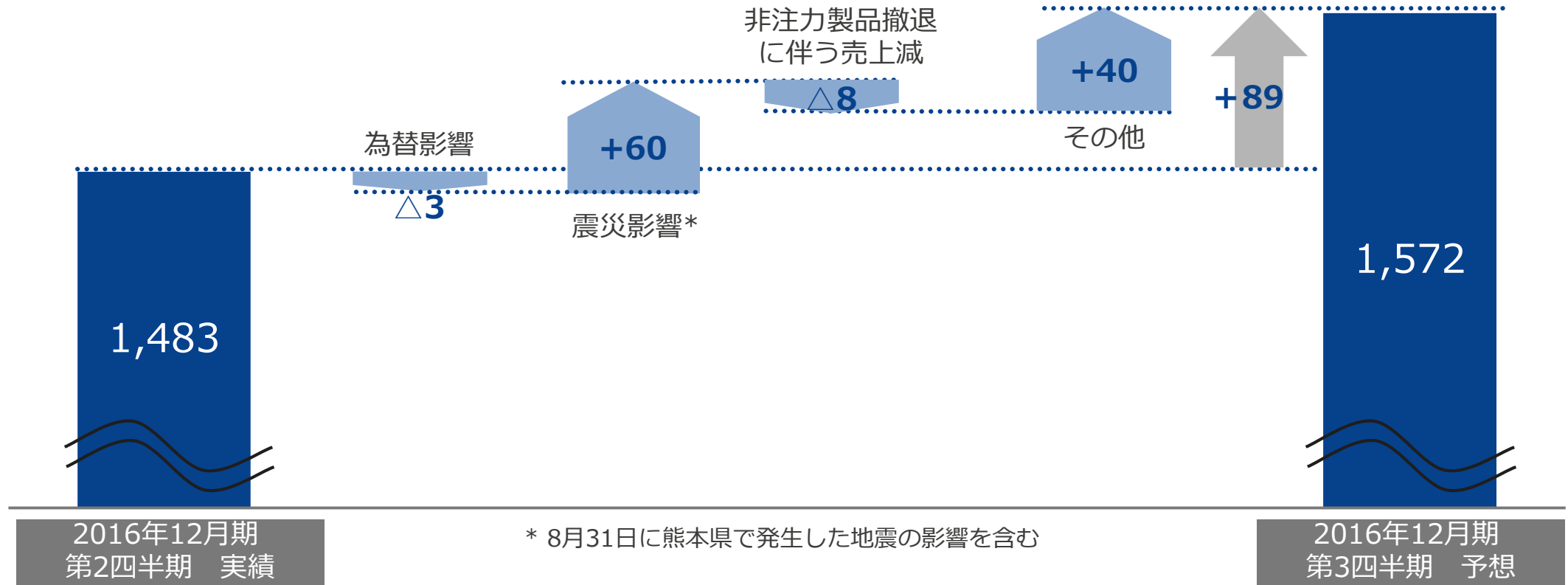
2016年12月期 第3四半期および通期 業績予想

売上高、半導体売上高の前年同期比、前四半期比、予想比は小数点第2位以下を四捨五入

(億円)	2016年3月期		2016年12月期				
	第3四半期	9か月間累計	第2四半期	第3四半期 予想	前年同期比	前四半期比	通期予想 (9ヶ月間累計)
売上高	1,648	5,255	1,526	1,614	△2.1%	+5.7%	4,660
半導体売上高	1,609	5,124	1,483	1,572	△2.3%	+6.0%	4,530
売上総利益率	43.6%	45.1%	41.2%	42.8%	△0.8Pts.	+1.5Pts.	42.3%
営業利益(率)	250 (15.1%)	881 (16.8%)	146 (9.5%)	209 (12.9%)	△41 (△2.2Pts.)	+63 (+3.4Pts.)	540 (11.6%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	186	760	94	176	△10	+82	370
EBITDA ^{*1}	410	1,349	295	364	△46	+69	990
1米ドル	121円	122円	104円	104円	17円円高	-	106円
1ユーロ	134円	134円	116円	114円	20円円高	2円円高	118円

2016年12月期 第3四半期 半導体売上高 予想

前四半期比（億円）



APPENDIX

GAAPとNon-GAAP間の調整項目

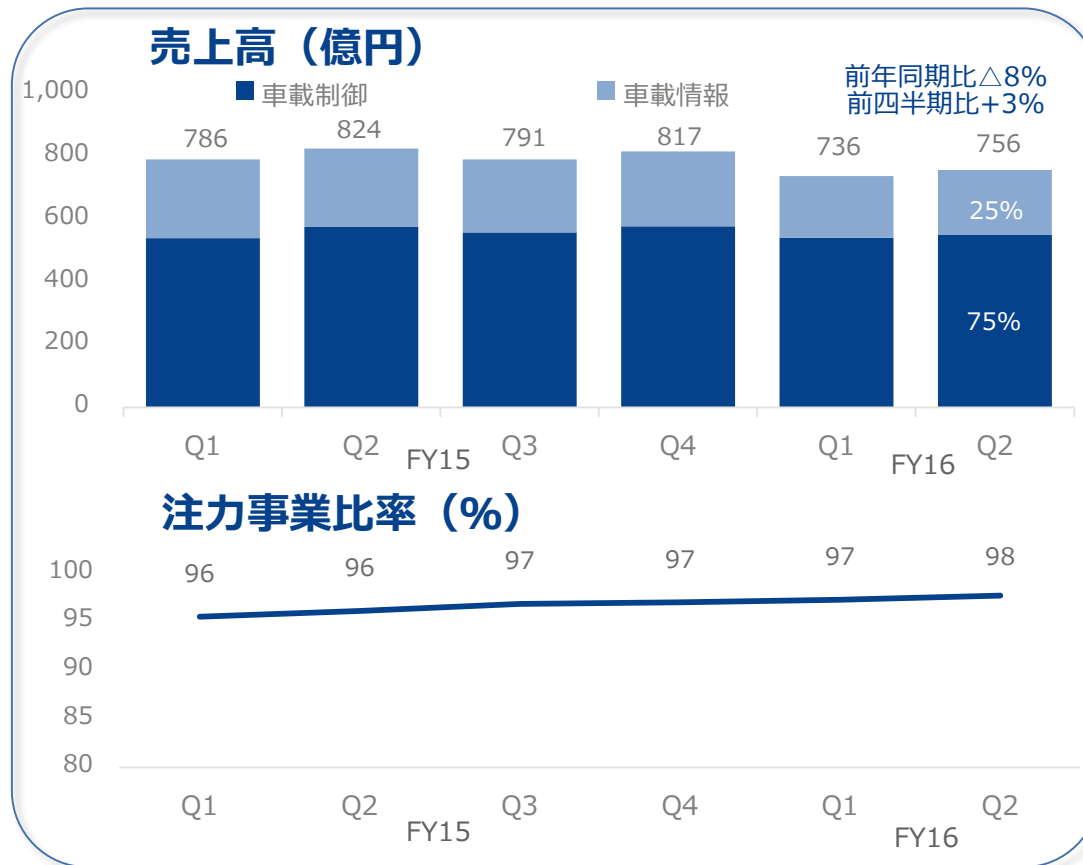
(億円)	2015年3月期				2016年3月期				2016年12月期	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	前4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
半導体売上高 (GAAP) ①	2,012	1,996	1,774	1,751	1,745	1,770	1,609	1,632	1,475	1,483
RSP*1②	△176	△210	-	-	-	-	-	-	-	-
半導体売上高 (Non-GAAP) ①+②	1,836	1,786	1,774	1,751	1,745	1,770	1,609	1,632	1,475	1,483
売上総利益 (GAAP) ①	805	816	786	781	798	855	718	685	651	629
RSP②	△60	△64	-	-	-	-	-	-	-	-
作り貯め*2③	△26	△17	△17	△14	△4	△23	△23	+21	+23	+20
売上総利益 (Non-GAAP) ①+②+③	719	735	769	767	794	832	695	706	674	649
営業利益 (GAAP) ①	270	235	295	244	324	307	250	157	186	146
RSP②	△39	△40	-	-	-	-	-	-	-	-
作り貯め④	△26	△17	△17	△14	△4	△23	△23	+21	+23	+20
営業利益 (Non-GAAP) ①+②+③+④	205	179	278	230	320	284	227	178	209	166
R&D (RSP)	18	19	-	-	-	-	-	-	-	-
SG&A (RSP)	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 RSP：2014年10月1日に譲渡したルネサスエスピードライバの売上高および営業損益

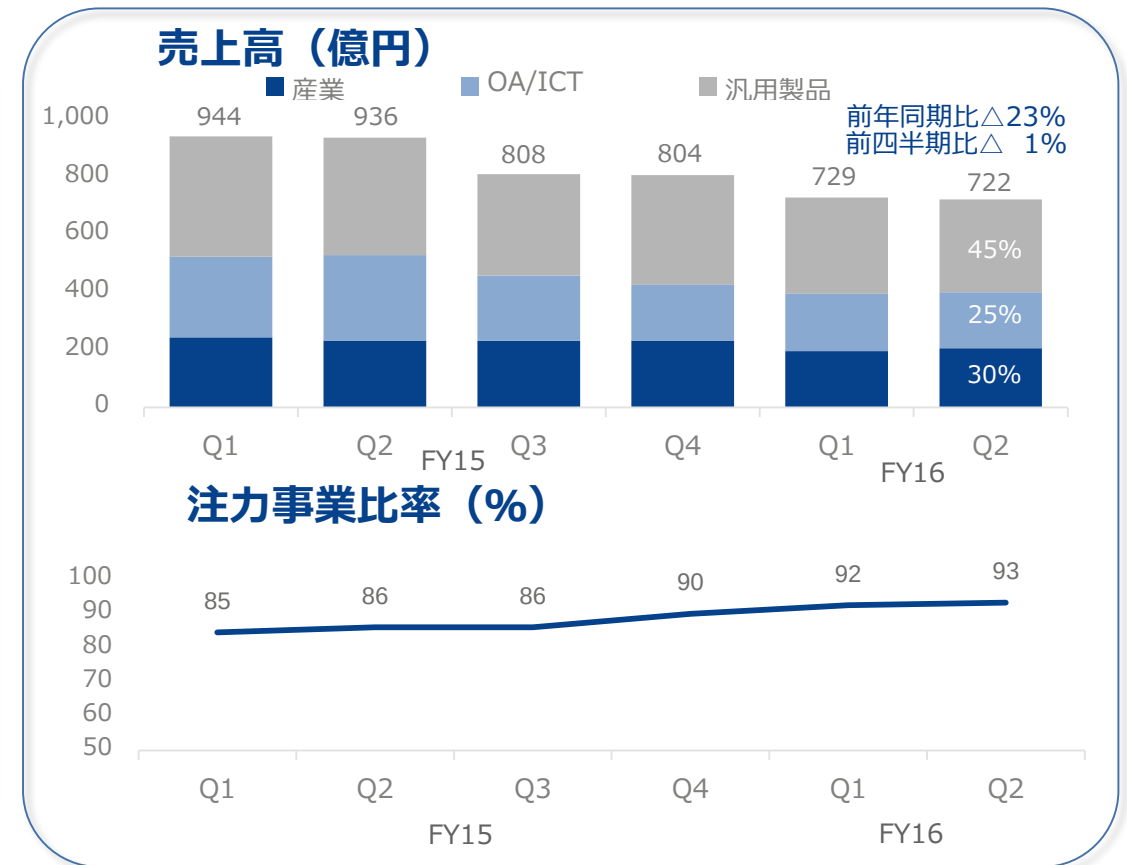
*2 作り貯め：工場再編に伴う、EOL製品の作り貯めにかかる損益

半導体売上高の事業別推移(Non-GAAPベース)

自動車向け事業

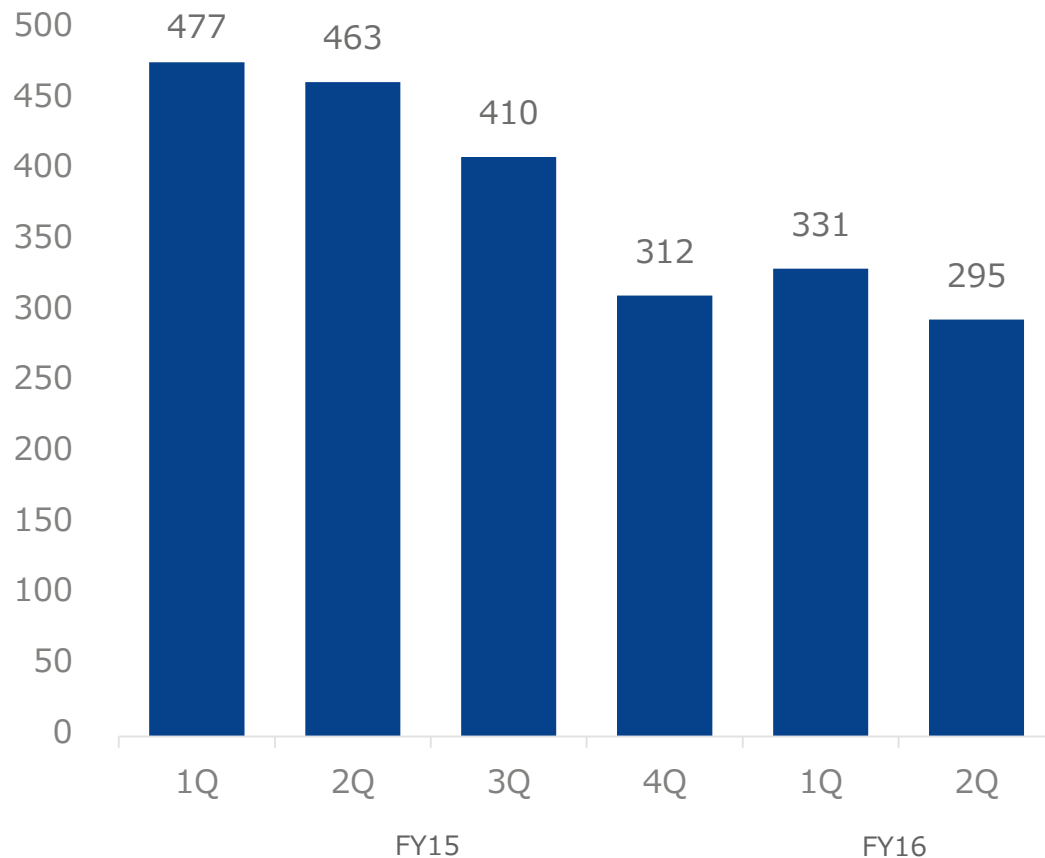


汎用向け事業

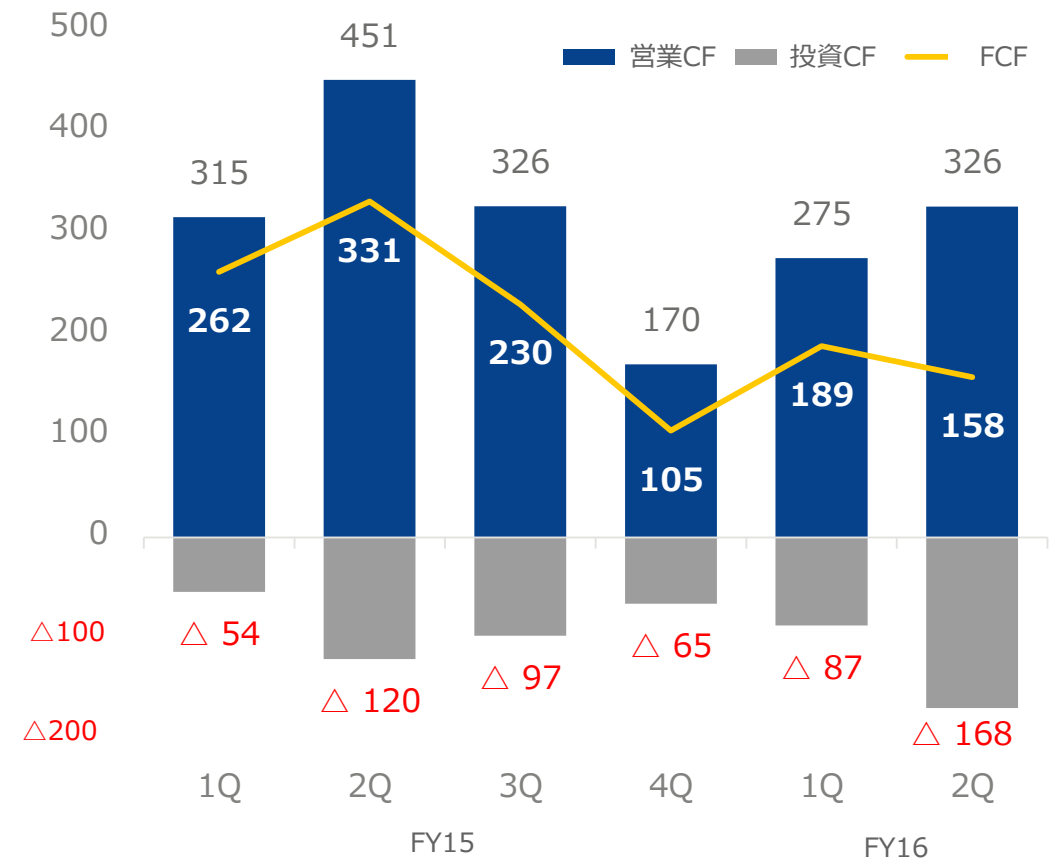


EBITDAおよびキャッシュ・フローの状況

EBITDA (億円)



キャッシュ・フロー (億円)



バランスシート of 状況

(億円)	2016年3月末	2016年6月末	2016年9月末
総資産	8,494	8,232	7,582
うち 現金及び現金同等物	3,984	3,973	3,262
うち たな卸資産	1,084	970	921
負債合計	4,676	4,477	3,762
うち 有利子負債	2,443	2,379	1,579
株主資本	3,641	3,741	3,835
純資産合計	3,817	3,755	3,820
D/Eレシオ (グロス)	0.64倍	0.64倍	0.42倍
自己資本比率	44.7%	45.4%	50.1%

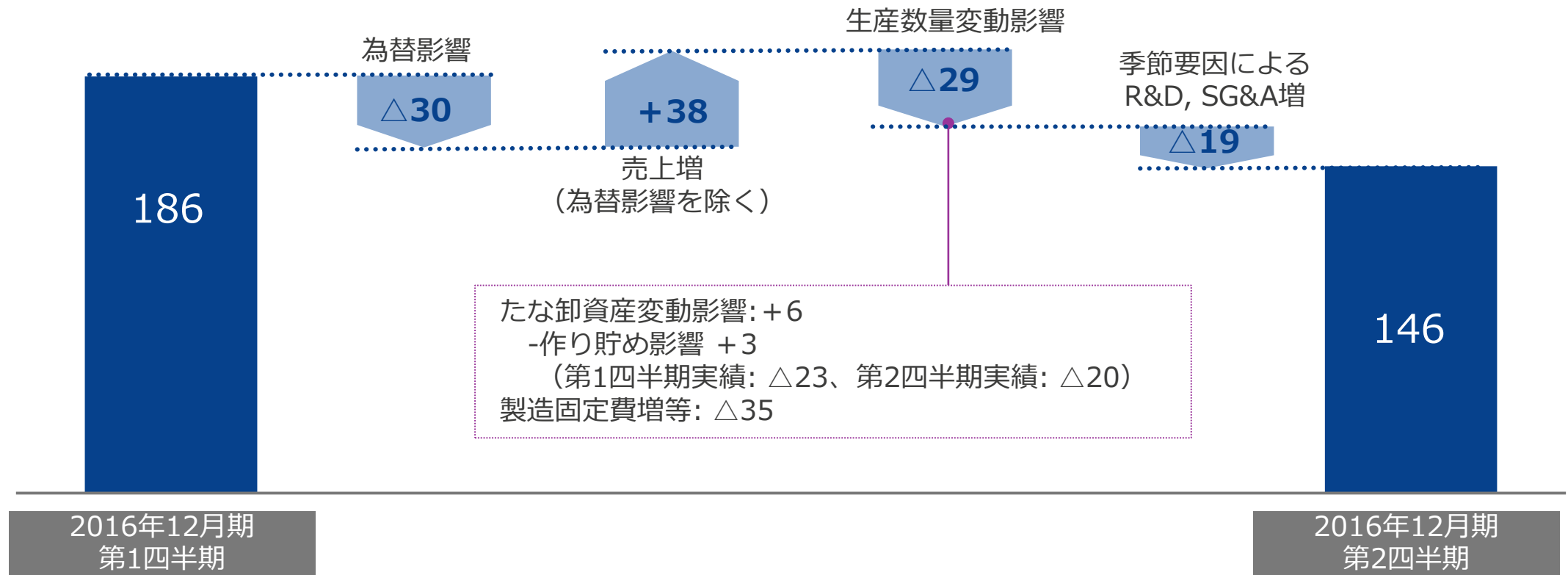
(注) ①現金及び現金同等物：「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。

②有利子負債：「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」

③自己資本：「株主資本」、「その他の包括利益累計額」 ④D/Eレシオ(グロス)：有利子負債／自己資本

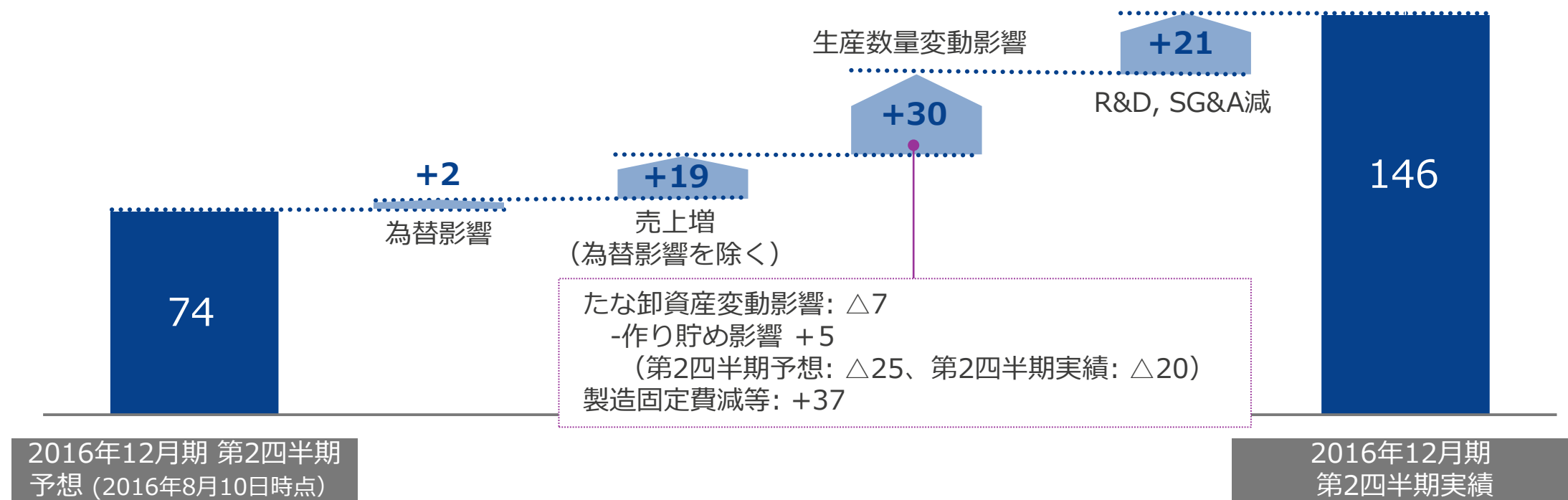
2016年12月期 第2四半期 営業利益

前四半期比 (億円)



2016年12月期 第2四半期 営業利益

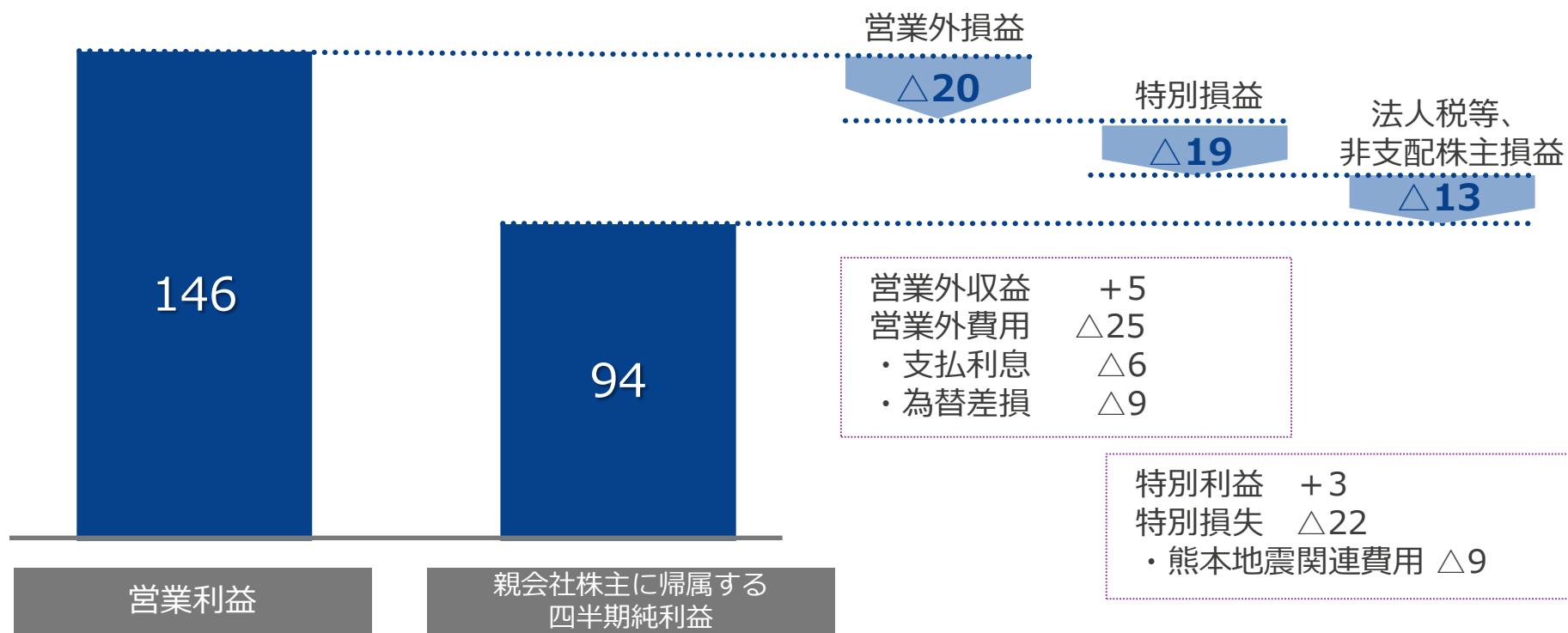
予想比 (億円)



2016年12月期 第2四半期

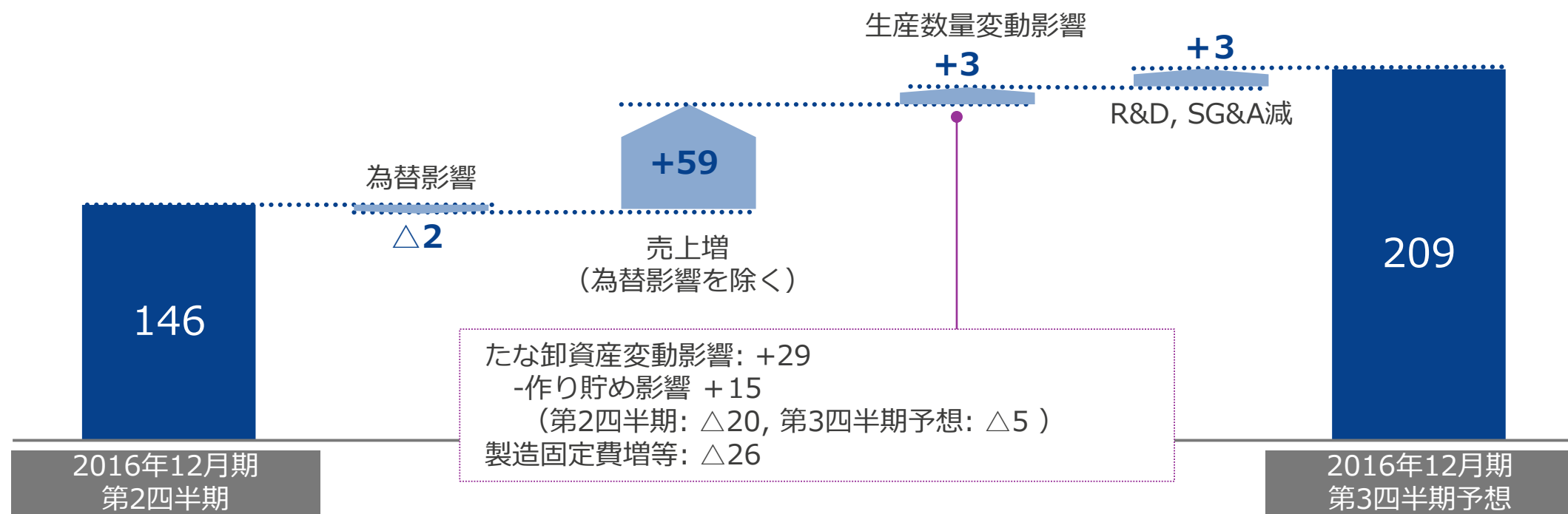
親会社株主に帰属する四半期純利益

(億円)



2016年12月期 第3四半期 営業利益予想

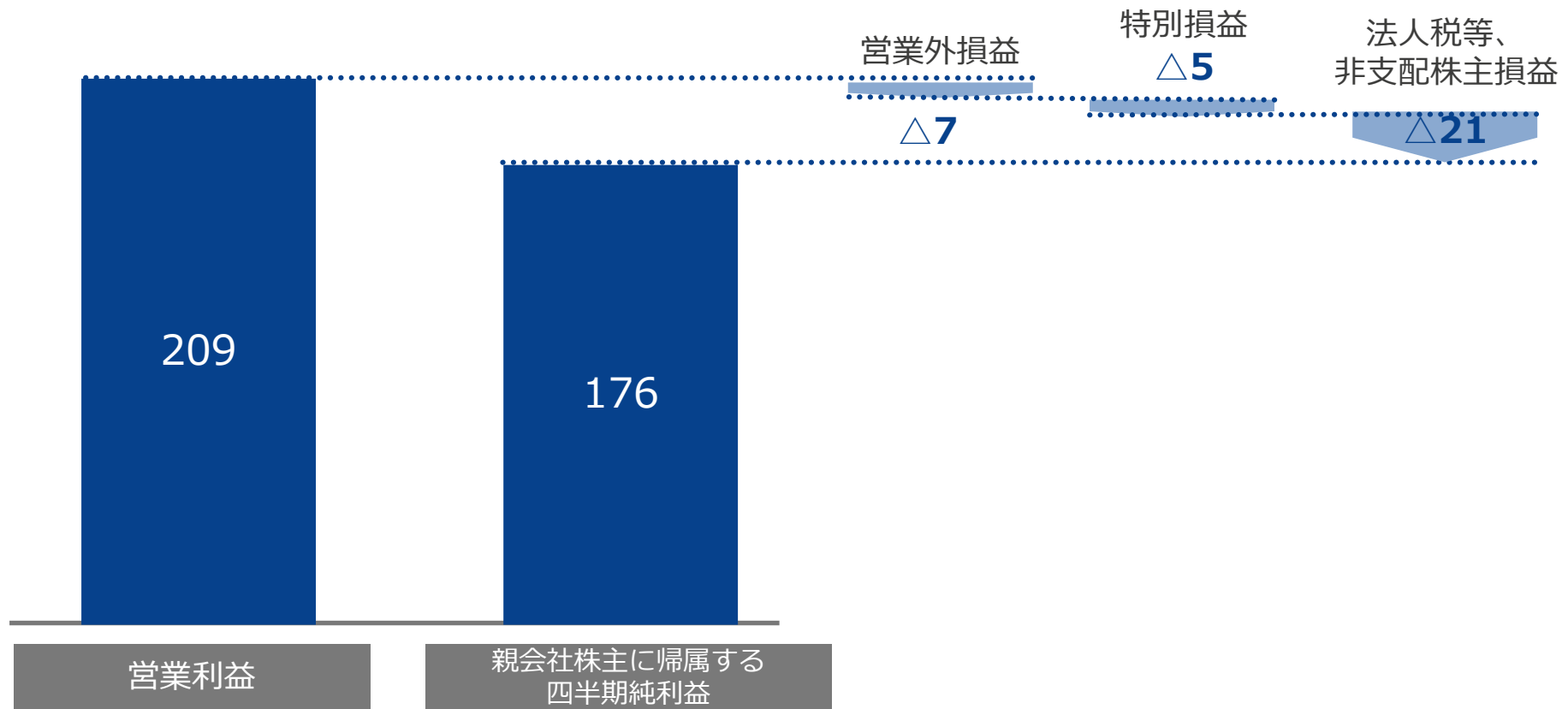
前四半期比（億円）



2016年12月期 第3四半期

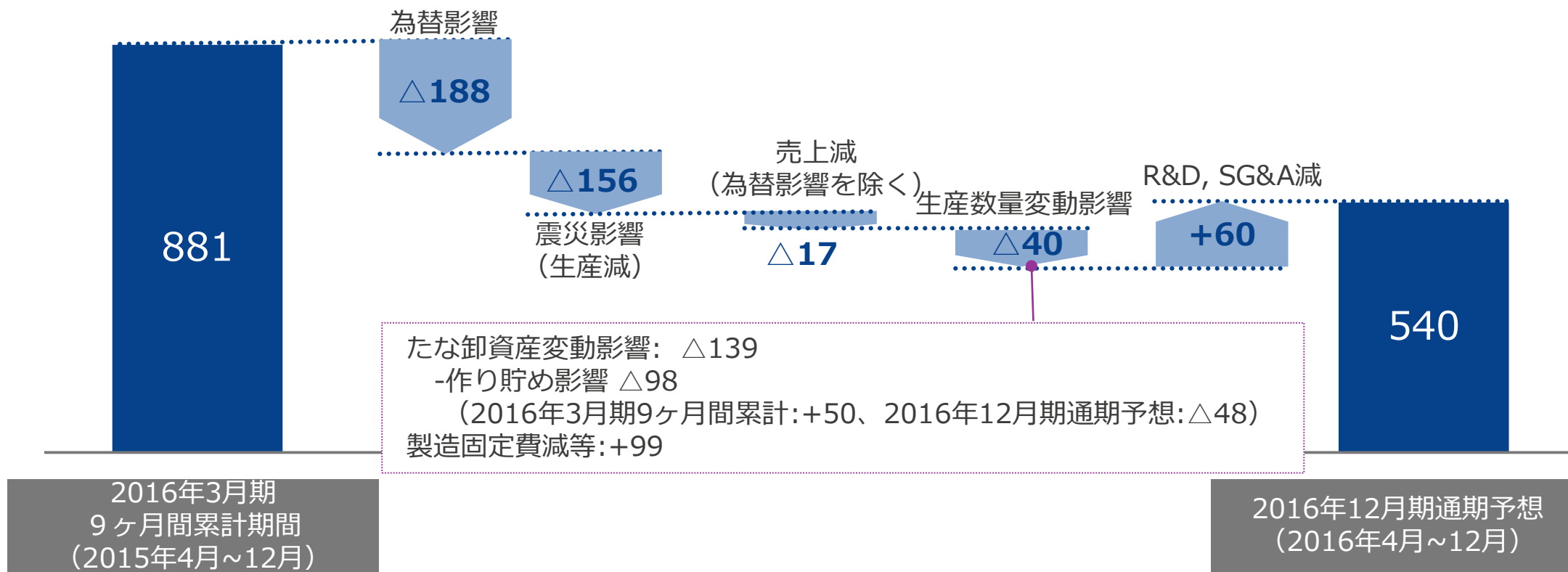
親会社株主に帰属する四半期純利益予想

(億円)



2016年12月期 通期 営業利益予想

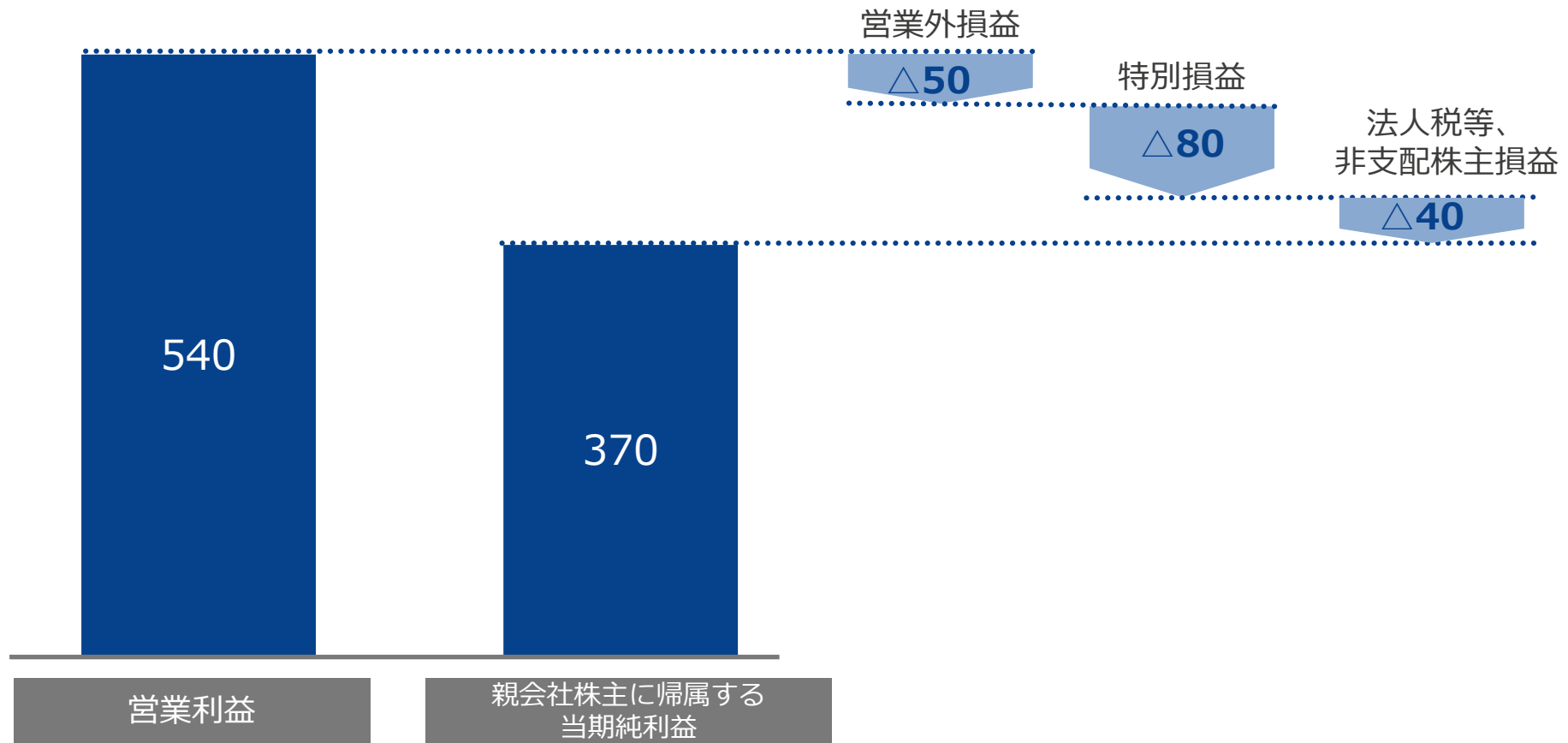
前年同期比 (億円)



2016年12月期 通期

親会社株主に帰属する当期純利益予想

(億円)



(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、（１）ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、（２）市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、（３）激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、（４）為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。